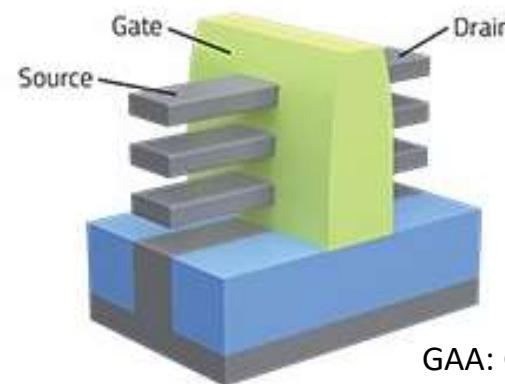


～ 2nm世代半導体の実現 ～

Rapidus株式会社は、世界最先端となるGAA Nano-sheet構造の2nm世代以降の半導体の製造に向けて始動した会社です。既に量産に向けた開発を、国際・国内連携のもと、進めています。

ここ川崎においては、試作されたトランジスタの電気特性の測定から、2nm世代半導体のデバイス物理の理解を深めます。これにより、プロセス改善・性能向上に結び付けていきます。

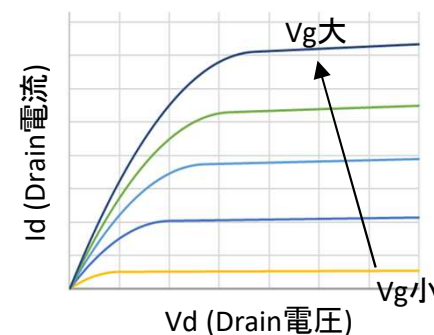
GAA Nano Sheet構造



GAA: Gate All Around

電気特性の解析

イメージ図



ものづくり系